



三洋半導体ニュース

No. N 7430
D2503

新

4AM01MH5 — エクセレントパワーデバイス ハイサイドスイッチ

- 特長**
- ・ハイサイドスイッチ。
(インバータ入力)
 - ・25V 動作が可能。
 - ・低電力損失。
 - ・Pch MOSFET オープンドレイン出力。

真理値表

IN	OUT
L	Z
H	H

H : 高レベル電圧
L : 低レベル電圧
Z : 高インピーダンス

絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings / Ta=25

DC 電源電圧	VDD	- 0.3 ~ + 25	unit
入力電圧	VIN	- 0.3 ~ VDD + 0.3	V
出力電圧	VOUT	VDD - 25 ~ VDD + 0.3	V
入力電流	IIN	± 10	mA
出力電流	IOUT	75	mA
許容損失	PD	セラミック基板(600mm ² × 0.8mm)装着時	0.8
保存周囲温度	Tstg	- 55 ~ + 150	W

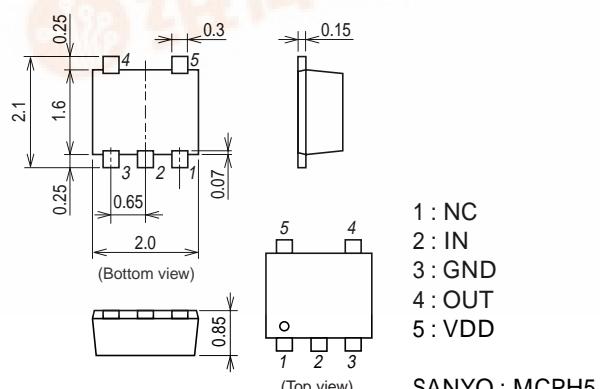
推奨動作条件 Recommended Operating Conditions / Ta=25

DC 電源電圧	VDD	3 ~ + 25	unit
入力電圧	VIN	0 ~ VDD	V
出力電圧	VOUT	VDD - 25 ~ VDD	V
入力上昇・下降時間	Δt / Δv	VDD < 5V VDD = 5V	100 ns / V 20 ns / V
動作周囲温度	Topr	- 40 ~ + 85	

单品品名表示 : XG

外形図 2217

(unit : mm)



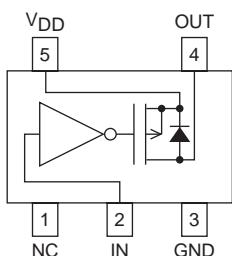
■本書記載の製品は、極めて高度の信頼性を
要する用途(生命維持装置、航空機のコント
ロールシステム等、多大な人的・物的損害
を及ぼす恐れのある用途)に対応する仕様には
はなっておりません。そのような場合には、
あらかじめ三洋電機販売窓口までご相談下
さい。

■本書記載の規格値(最大定格、動作条件範囲
等)を瞬時たりとも越えて使用し、その結果
発生した機器の欠陥について、弊社は責任
を負いません。

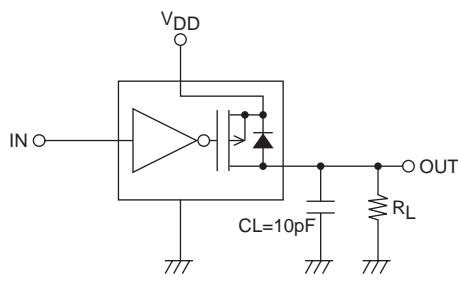
4AM01MH5

DC 特性 DC Characteristics / Ta=25			min	typ	max	unit
高レベル入力電圧	V _{IH}	V _{DD} =5V	3.5			V
		V _{DD} =10V	7.0			V
		V _{DD} =15V	11.0			V
		V _{DD} =25V	18.0			V
低レベル入力電圧	V _{IL}	V _{DD} =5V		1.5		V
		V _{DD} =10V		3.0		V
		V _{DD} =15V		4.0		V
		V _{DD} =25V		7.0		V
入力もれ電流	I _{IN}	V _{DD} =25V, V _{IN} =25V		0.1		μA
		V _{DD} =25V, V _{IN} =0		0.1		μA
高レベル出力電圧	V _{OH}	V _{DD} =5V, I _O =1mA	4.5			V
		V _{DD} =10V, I _O =2.5mA	9.0			V
		V _{DD} =15V, I _O =5.0mA	13.5			V
		V _{DD} =25V, I _O =10mA	22.5			V
電源電流	I _{DD}	V _{DD} =5V, V _{IN} =V _{DD} , GND		0.25		μA
		V _{DD} =10V, V _{IN} =V _{DD} , GND		0.5		μA
		V _{DD} =15V, V _{IN} =V _{DD} , GND		1.0		μA
		V _{DD} =25V, V _{IN} =V _{DD} , GND		2.0		μA
AC 特性 AC Characteristics / Ta=25			min	typ	max	unit
伝播遅延時間	t _{PZH}	V _{DD} =5V, R _L =1.5kΩ	40			ns
		V _{DD} =10V, R _L =1kΩ	20			ns
		V _{DD} =15V, R _L =750Ω	15			ns
		V _{DD} =25V, R _L =500Ω	12			ns
	t _{PHZ}	V _{DD} =5V, R _L =1.5kΩ	30			ns
		V _{DD} =10V, R _L =1kΩ	20			ns
		V _{DD} =15V, R _L =750Ω	15			ns
		V _{DD} =25V, R _L =500Ω	12			ns
入力容量	C _{IN}			8		pF

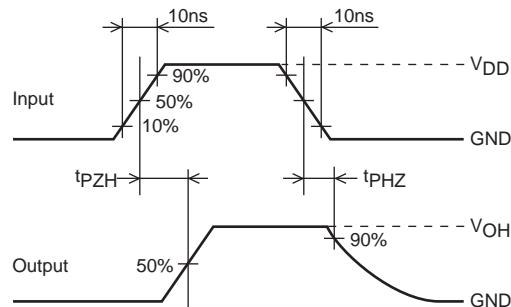
ブロック図



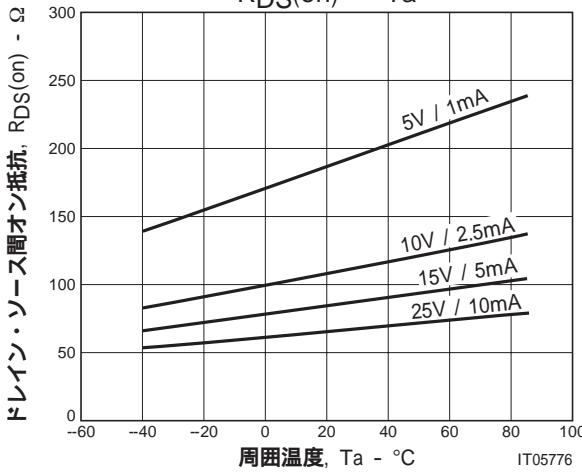
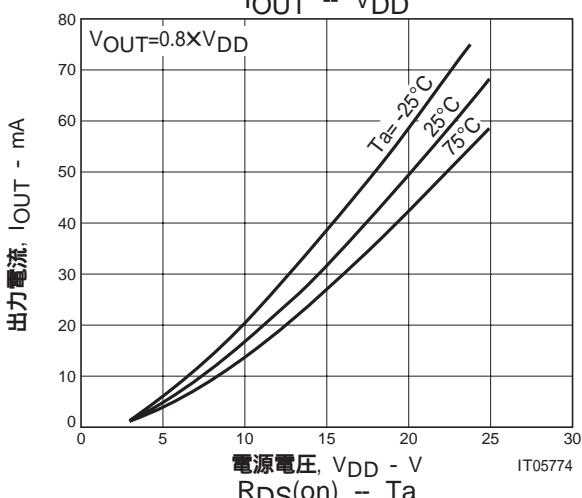
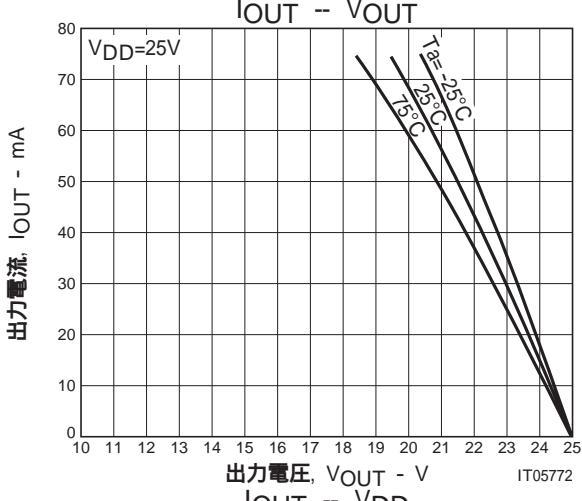
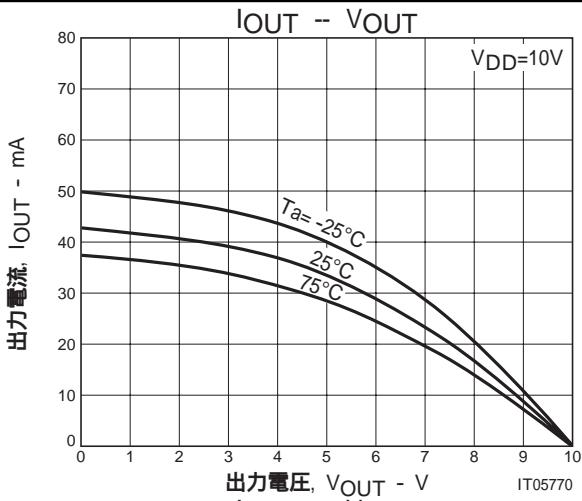
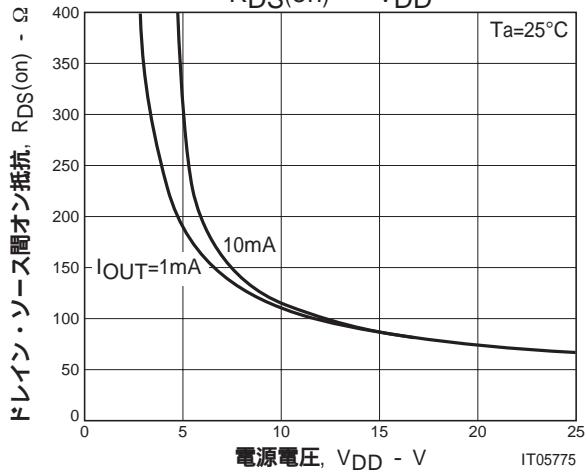
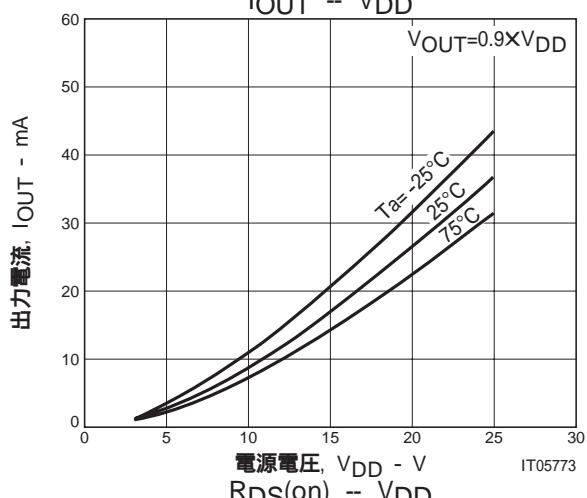
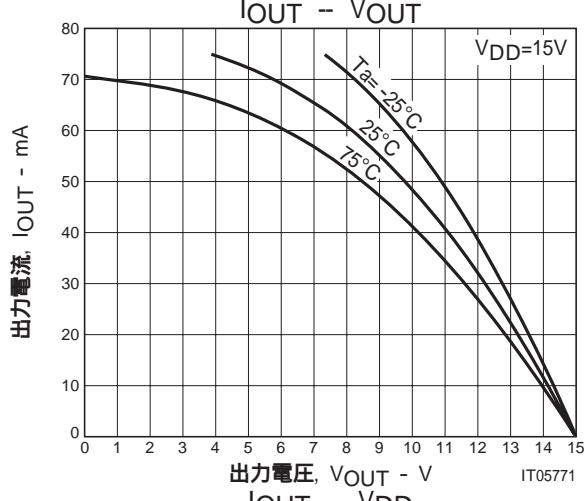
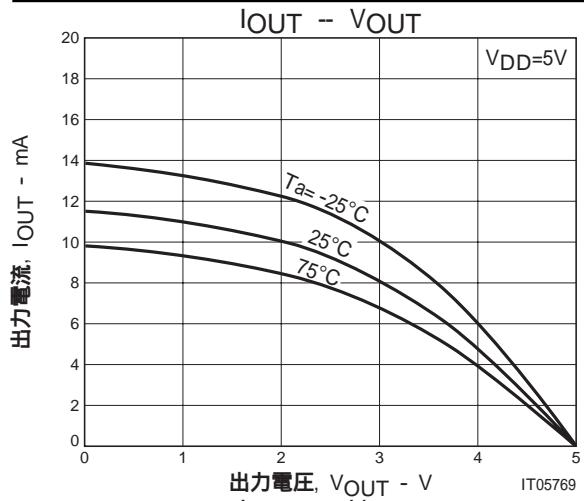
スイッチングタイム測定回路図



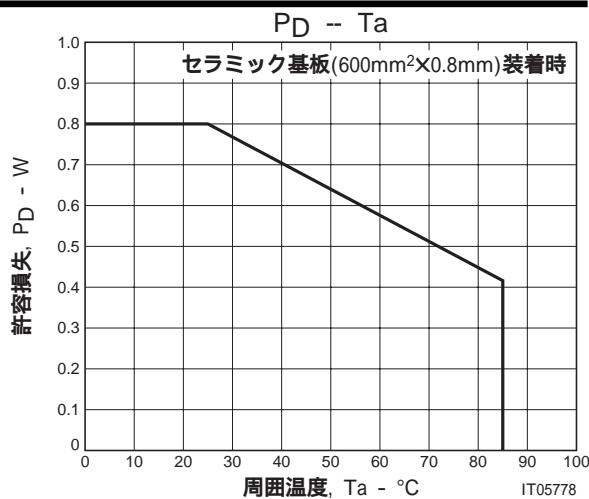
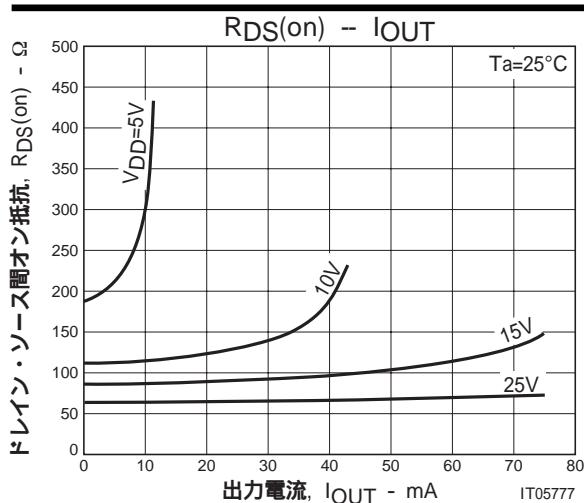
スイッチングタイム波形図



4AM01MH5



4AM01MH5



- 本書記載の製品は、定められた条件下において、記載部品単体の性能・特性・機能などを規定するものであり、お客様の製品（機器）での性能・特性・機能などを保証するものではありません。部品単体の評価では予測できない症状・事態を確認するためにも、お客様の製品で必要とされる評価・試験を必ず行って下さい。
- 弊社は、高品質・高信頼性の製品を供給することに努めています。しかし、半導体製品はある確率で故障が生じてしまいます。この故障が原因となり、人命にかかる事故、発煙・発火事故、他の物品に損害を与える事故などを引き起こす可能性があります。機器設計時には、このような事故を起こさないよう、保護回路・誤動作防止回路等の安全設計、冗長設計・機構設計等の安全対策を行って下さい。
- 本書記載の製品が、外国為替及び外国貿易法に定める規制貨物（役務を含む）に該当する場合、輸出する際に同法に基づく輸出許可が必要です。
- 弊社の承諾なしに、本書の一部または全部を、転載または複製することを禁止します。
- 本書に記載された内容は、製品改善および技術改良等により将来予告なしに変更することがあります。したがって、ご使用の際には、「納入仕様書」でご確認下さい。
- この資料の情報（掲載回路および回路定数を含む）は一例を示すもので、量産セットとしての設計を保証するものではありません。また、この資料は正確かつ信頼すべきものであると確信しておりますが、その使用にあたって第3者の工業所有権その他の権利の実施に対する保証を行うものではありません。